









	<h2>SI3443DDV-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI3443DDV-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CHAN 20V TSOP6S</p> <p>Datenblätter:  SI3443DDV-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 45277 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3443DDV-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CHAN 20V TSOP6S
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	45277 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 4A (Ta), 5.3A (Tc) 1.7W (Ta), 2.7W
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	1.7W (Ta), 2.7W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4A (Ta), 5.3A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	47 mOhm @ 4.5A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 8V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	970pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI3443DDV-T1-GE3CT

SI3443DDV-T1-GE3 ist neu im Original. Suche SI3443DDV-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3443DDV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3443DDV-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI3443DV Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 4A SSOT-6</p>	 <p>SI3443CDV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 5.97A 6TSOP</p>	 <p>SI3443DV AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 4A SSOT-6</p>	 <p>SI3443DL-T1-E3 VISHAY VISHAY SOT-23</p>
 <p>SI3443DV International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET P-CH 20V 4.4A 6-TSOP</p>	 <p>SI3443DDV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CHAN 20V TSOP6S</p>	 <p>SI3443CDV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 5.97A 6TSOP</p>	 <p>SI3443CDV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 5.97A 6TSOP</p>

heiße Teile

Mehr

 SI3441DV-T2	 SI3441DV-T1-E3	 SI3442BDV	 SI3442BDV-T1-E3	 SI3442BDV-T1-E3
 SI3442BDV-T1-GE3	 SI3442BDV-T1-GE3	 SI3442CDV-T1-GE3	 SI3442CDV-T1-GE3	 SI3442DV
 SI3442DV	 SI3442DV-T1	 SI3442DV-T1-E3	 SI3442DV-T1-GE3	 SI3443ADV-T1-E3
 SI3443BDV	 SI3443BDV-T1-E3	 SI3443BDV-T1-E3	 SI3443BDV-T1-GE3	 SI3443BDV-T1-GE3
 SI3443BVD	 SI3443CDV-T1-E3	 SI3443CDV-T1-E3	 SI3443CDV-T1-GE3	 SI3443CDV-T1-GE3
 SI3443DDV-T1-GE3	 SI3443DV	 SI3443DV	 SI3443DV	 SI3443DV-NL
 SI3443DV-T1	 SI3443DV-T1-E3	 SI3443DV-T1-GE3	 SI3443DVTR	 SI3443DVTRPBF
 SI3445ADV-T1	 SI3445ADV-T1-E3	 SI3445ADV-T1-E3	 SI3445ADV-T1-GE3	 SI3445ADV-T1-GE3
 SI3445BDV	 SI3445DV	 SI3445DV-T1	 SI3445DV-T1-E3	 SI3445DV-T1-E3
 SI3445DV-T1-E3	 SI3445DV-T1-GE3	 SI3445DV-T1-GE3	 SI3446ADV-T1	 SI3446ADV-T1-E3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited